# JP5080530

Publication Title:

PRODUCTION OF THIN FILM PATTERN

Abstract:

Abstract of JP5080530

PURPOSE:To provide a production method for a thin film pattern having high throughput and needless to join together mask patterns even when using a substrate of large area. CONSTITUTION:In the production method for the thin film pattern by forming and arranging the mask pattern 5 on the thin film 2 after the thin film 2 is provided on the substrate 1 and by removing the exposed part of the thin film 2 by etching to execute patterning of the thin film 2, the organic resin layer 3 is formed by uniformly applying an organic resin on the whole surface of the substrate 1 provided with the thin film 2 and the mask pattern 5 is formed on the thin film 2 by pressing the organic resin layer 3 with the stamper 4 having the same unevenness as the mask pattern 5 and almost the same dimension as the substrate 1.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

\_\_\_\_\_

Courtesy of http://v3.espacenet.com

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平5-80530

(43)公開日 平成5年(1993)4月2日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 3 F C 2 3 F H 0 1 L	7/26 1/00 21/027	識別記号 102	庁内整理番号 7124-2H 7179-4K	FΙ	技術表示箇所
	21/302	J	7353 – 4M		
			7352 - 4M	H 0 1 L	21/30 3 6 1 E
				審查請求 未請求	請求項の数8(全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<b>∄</b>	特願平3-270458		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日		平成3年(1991)9月24日			東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
				(72)発明者	桑原 和広 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内
				(72)発明者	森、祐二
					茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内
				(72)発明者	三上 佳朗 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内
				(74)代理人	F

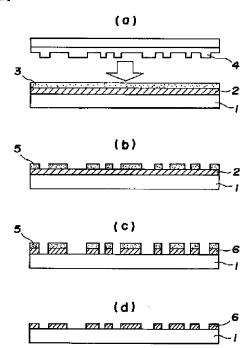
# (54) 【発明の名称】 薄膜パターン製造方法

### (57)【要約】

【目的】 大面積の基板1を用いた場合でも、高いスル ープットを有し、かつ、マスクパターン5のつなぎ合わ せの必要がない薄膜パターン製造方法の提供。

【構成】 基板1上に薄膜2を装着させた後、薄膜2上 にマスクパターン5を形成配置し、次いで露出している **薄膜2部分をエッチングにより除去して薄膜2のパター** ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、薄膜2 を装着させた基板1上に有機樹脂を全面に均一に塗布す ることにより有機樹脂層3を形成し、さらに、マスクパ ターン5と同一の凹凸を有し、かつ、基板1とほぼ同一 寸法のスタンパ4を用いて有機樹脂層3の型押しを行な うことにより、薄膜2上にマスクパターン5を形成す る。

## [図1]



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜 上にマスクパターンを形成配置し、次いで露出している 薄膜部分をエッチングにより除去して前記薄膜のパター ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄 膜を装着させた基板上に有機樹脂を全面に均一に塗布す ることにより有機樹脂層を形成し、さらに、マスクパタ ーンと同一の凹凸を有し、かつ、前記基板とほぼ同一寸 法のスタンパを用いて前記有機樹脂層の型押しを行なう ことにより、前記薄膜上にマスクパターンを形成するこ 10 とを特徴とする薄膜パターン製造方法。

【請求項2】 前記スタンパは光透過性を有する材質か らなっていることを特徴とする請求項1記載の薄膜パタ ーン製造方法。

【請求項3】 前記有機樹脂は光硬化性の樹脂からな り、また、前記スタンパは光透過性を有する材質からな っていて、前記有機樹脂層の型押しを行なった後に、前 記スタンパを通して前記有機樹脂層に光を投射させ、前 記有機樹脂層を硬化させてマスクパターンを形成するこ とを特徴とする請求項1記載の薄膜パターン製造方法。

前記有機樹脂は光硬化性の樹脂からな 【請求項4】 り、また、前記スタンパは光透過性を有する材質からな っていて、前記スタンパの凹部あるいは凸部の一方に遮 光層が設けられ、前記スタンパにより前記有機樹脂層の 型押しを行なった後に、前記スタンパを通して前記有機 樹脂層に光を投射させることにより、前記有機樹脂層の 光の投射部分を硬化させてマスクパターンを形成するこ とを特徴とする請求項1記載の薄膜パターン製造方法。

【請求項5】 基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜 薄膜部分をエッチングにより除去して前記薄膜のパター ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄 膜を装着させた基板上に有機樹脂を全面に均一に塗布す ることにより有機樹脂層を形成し、さらに、マスクパタ ーンと同一の凹凸を有し、かつ、前記基板の幅とほぼ同 一の長さを有する回転可能な円筒状スタンパを用意し、 前記円筒状スタンパを回転させつつ前記有機樹脂層の型 押しを行なうことにより、前記薄膜上にマスクパターン を形成することを特徴とする薄膜パターン製造方法。

【請求項6】 基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜 40 上にマスクパターンを形成配置し、次いで露出している 薄膜部分をエッチングにより除去して前記薄膜のパター ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄 膜を装着させた基板に近接してマスクパターンと同一の 凹凸を有し、かつ、前記基板の幅とほぼ同一の長さを有 する円筒状スタンパを配置し、前記基板と前記円筒状ス タンパとを同期的に移動及び回転させると共に、前記薄 膜を装着させた基板上の前記円筒状スタンパの上流側に 有機樹脂を流し込み、この有機樹脂を前記円筒状スタン

ターンを形成することを特徴とする薄膜パターン製造方

基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜 【請求項7】 上にマスクパターンを形成配置し、次いで露出している 薄膜部分をエッチングにより除去して前記薄膜のパター ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄 膜を装着させた基板に近接してマスクパターンと同一の 凹凸を有し、かつ、前記基板の幅とほぼ同一の長さを有 する円筒状スタンパを配置し、前記基板と前記円筒状ス タンパとを同期させて移動及び回転させると共に、前記 円筒状スタンパの凹部に有機樹脂を流し込み、前記基板 と前記円筒状スタンパとが接触する際に前記有機樹脂を 前記基板上に転写させることにより、前記薄膜上にマス クパターンを形成することを特徴とする薄膜パターン製 造方法。

【請求項8】 前記移動する基板の円筒状スタンパの下 流側に加熱装置を配置し、前記円筒状スタンパによって 前記基板上に形成された有機樹脂部分を硬化させること により、前記薄膜上にマスクパターンを形成することを 20 特徴とする請求項5、6および7記載の薄膜パターン製

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜パターン製造方法 に係り、特に、大面積の基板上に薄膜パターンを形成す る場合に、エッチング用の大規模なマスクパターンを得 ることができる薄膜パターン製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、エッチング手段を用いた薄膜パタ 上にマスクパターンを形成配置し、次いで露出している 30 ーン製造方法においては、フォトリソグラフィーによっ て保護用のマスクを形成することが慣用されており、そ のような慣用手段は、例えば、永田 穰、柳井久義著 「改訂集積回路工学(1)」コロナ社(昭62)発行、 第89頁乃至第91頁に記載されている。

> 【0003】図6の(a) 乃至(d) は、前記慣用手段 に係る薄膜パターン製造工程の概略を示す構成図であ

> 【0004】図6において、10は基板、11は導体ま たは半導体あるいは絶縁体の薄膜、12は感光性有機樹 脂層、12aは感光部、12bは未感光部、13は透光 性のフォトマスク、14はフォトマスク13の遮光部、 15はマスクパターン、16は薄膜パターンであり、こ れら感光性有機樹脂層12及びフォトマスク13はネガ 型のものが用いられている。

【0005】いま、前記薄膜11を平面方向にパターニ ングを行なう場合には、まず、図の(a)に示すよう に、基板10上に適宜の手段により導体または半導体あ るいは絶縁体の薄膜11を形成し、こうして形成した薄 膜11上に感光性有機樹脂12を塗布して感光性有機樹 パで型押しを行なうことにより、前記薄膜上にマスクパ 50 脂層12を形成する。次いで、この感光性有機樹脂層1

1の手段を備える。

3

2上にフォトマスク13の位置合わせを行ない、位置合 わせが完了した後にフォトマスク13を通して感光性有 機樹脂層12に紫外線(UV)を照射させる。この紫外 線(UV)は、フォトマスク13を透過して感光性有機 樹脂層12を感光させるが、フォトマスク13の遮光部 14においては紫外線(UV)が透過を阻止されるの で、感光性有機樹脂層12には感光部12aと未感光部 12bとが形成される。次に、図の(b)に示すよう に、感光性有機樹脂層12の感光部12aと未感光部1 液に対する感光部12 a の溶解度は低いのに対して、未 感光部12bの溶解度は高いので、前記処理後に感光部 12 aのみが残存し、マスクパターン15が形成され る。続いて、図の(c)に示すように、マスクパターン 15の部分をエッチング用保護マスクとして、薄膜11 にウエットエッチングあるいはドライエッチングを施 し、薄膜11におけるマスクパターン15の部分以外の 部分をエッチング除去する。その後、図の(d)に示す ように、感光部12aであるマスクパターン15の部分 を剥離用の溶剤あるいはプラズマアッシャ等により除去 20 し、基板10上にマスクパターン15と同様の薄膜パタ ーン16を形成するようにしている。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】フォトマスク13を用 いて感光性有機樹脂層12を露光させる場合、その露光 条件が感光性有機樹脂層12に対するマスクパターンの 転写精度に大きく関係するため、基板10全体を均一な 照度によって一括露光することが望ましい。

【0007】しかしながら、前記従来の慣用手段におい ては、このような露光を行なう露光装置を大型化するに 30 は限度があり、一括露光できる範囲を大きくすることは 困難であった。このため、大面積の基板10に前述のよ うなマスクパターン15の転写を行なう場合には、基板 10を複数の領域に分け、それら領域ごとにそれぞれ各 別に露光を行っていた。ところが、こうした複数の領域 にそれぞれ露光を行なうようにすれば、全体のスループ ットが低下し、さらに、各領域の境界部分においてマス クパターン15のつなぎ合わせ精度が悪くなるという問 題が生じる。

【0008】本発明は、前述の問題点を解消するための 40 もので、その目的は、大面積の基板を用いた場合におい ても、高いスループットを有し、かつ、マスクパターン のつなぎ合わせの必要がない薄膜パターン製造方法を提 供することにある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明は、基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜 上にマスクパターンを形成配置し、次いで露出している 薄膜部分をエッチングにより除去して前記薄膜のパター ニングを行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄 50 ているので、前記基板全面には、その所定の位置に任意

膜を装着させた基板上に有機樹脂を全面に均一に塗布す ることにより有機樹脂層を形成し、さらに、マスクパタ ーンと同一の凹凸を有し、かつ、前記基板とほぼ同一寸 法のスタンパを用いて前記有機樹脂層の型押しを行なう ことにより、前記薄膜上にマスクパターンを形成する第

【0010】また、前記目的を達成するために、本発明 は、基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜上にマスク パターンを形成配置し、次いで露出している薄膜部分を 2 b に対して現像液による現像処理を行うと、この現像 10 エッチングにより除去して前記薄膜のパターニングを行 なう薄膜パターン製造方法において、前記薄膜を装着さ せた基板上に有機樹脂を全面に均一に塗布することによ り有機樹脂層を形成し、さらに、マスクパターンと同一 の凹凸を有し、かつ、前記基板の幅とほぼ同一の長さを 有する円筒状スタンパを用意し、前記円筒状スタンパを 回転させつつ前記有機樹脂層の型押しを行なうことによ り、前記薄膜上にマスクパターンを形成する第2の手段

> 【0011】さらに、前記目的を達成するために、本発 明は、基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜上にマス クパターンを形成配置し、次いで露出している薄膜部分 をエッチングにより除去して前記薄膜のパターニングを 行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄膜を装着 させた基板に近接してマスクパターンと同一の凹凸を有 し、かつ、前記基板の幅とほぼ同一の長さを有する円筒 状スタンパを配置し、前記基板と前記円筒状スタンパと を同期的に移動及び回転させると共に、前記薄膜を装着 させた基板上の前記円筒状スタンパの上流側に有機樹脂 を流し込み、この有機樹脂を前記円筒状スタンパで型押 しを行なうことにより、前記薄膜上にマスクパターンを 形成する第3の手段を備える。

> 【0012】この他に、前記目的を達成するために、木 発明は、基板上に薄膜を装着させた後、前記薄膜上にマ スクパターンを形成配置し、次いで露出している薄膜部 分をエッチングにより除去して前記薄膜のパターニング を行なう薄膜パターン製造方法において、前記薄膜を装 着させた基板に近接してマスクパターンと同一の凹凸を 有し、かつ、前記基板の幅とほぼ同一の長さを有する円 筒状スタンパを配置し、前記基板と前記円筒状スタンパ とを同期させて移動及び回転させると共に、前記円筒状 スタンパの凹部に有機樹脂を流し込み、前記基板と前記 円筒状スタンパとが接触する際に前記有機樹脂を前記基 板上に転写させることにより、前記薄膜上にマスクパタ ーンを形成する第4の手段を備える。

#### [0013]

【作用】前記第1の手段によれば、マスクパターンと同 一の凹凸を有し、かつ、基板とほぼ同一寸法のスタンパ を用い、基板上に塗布された有機樹脂層に前記スタンパ で型押しを行なってマスクパターンを形成するようにし

5

の寸法形状を有するマスクパターン(エッチング用の保 護マスク) が一度に一つの工程により形成される。この 手段においては、スタンパにより直接有機樹脂層の成型 を行なっているので、従来のこの種の手段で必要であっ た現像工程が不要になり、薄膜パターン製造の際のスル ープットの向上が可能になる。また、一度に基板全面に 有機樹脂層からなるマスクパターンが成型できるため、 大面積の基板のときでもマスクパターンのつなぎ合わせ が不要となり、基板全面に高い寸法精度で薄膜パターン が製造できる。

【0014】また、前記第2の手段によれば、マスクパ ターンと同一の凹凸を有し、かつ、基板の幅とほぼ同一 の長さを有する円筒状スタンパを用い、前記基板上に塗 布された有機樹脂層に回転する前記スタンパにより型押 しを行なってマスクパターンを形成するようにしている ので、前記基板全面には、その所定の位置に任意の寸法 形状を有するマスクパターン(エッチング用の保護マス ク)が順次繰返し一つの工程により形成される。

【0015】さらに、前記第3の手段によれば、マスク パターンと同一の凹凸を有し、かつ、基板の幅とほぼ同 20 一の長さを有する円筒状スタンパを用い、前記基板上に 流し込まれた有機樹脂に前記基板の移動と同期して回転 する前記スタンパで型押しを行なってマスクパターンを 形成するようにしているので、前記基板全面には、その 所定の位置に任意の寸法形状を有するマスクパターン (エッチング用の保護マスク) が順次繰返し一つの工程 により形成される。

【0016】最後に、前記第4の手段によれば、マスク パターンと同一の凹凸を有し、かつ、基板の幅とほぼ同 前記基板の移動と同期して回転する前記スタンパの凹部 に流し込まれた有機樹脂を転写してマスクパターンを形 成するようにしているので、前記基板全面には、その所 定の位置に任意の寸法形状を有するマスクパターン(エ ッチング用の保護マスク)が順次繰返し一つの工程によ り形成される。

【0017】前記第2乃至第4の手段においては、いず れのものも、スタンパにより直接有機樹脂層の成型を行 なっているので、前述の従来の現像工程が不要になり、 る。また、一つの工程により基板全面に有機樹脂層から なるマスクパターンが成型できるため、大面積の基板の ときでもマスクパターンのつなぎ合わせが不要となり、 基板全面に高い寸法精度で薄膜パターンが製造できる。

#### [0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す る。

【0019】図1の(a) 乃至(d) は、本発明に係る 薄膜パターン製造方法の第1の実施例を示す構成図であ る。

【0020】図1において、1は基板、2は導体または 半導体あるいは絶縁体の薄膜、3は有機樹脂層、4は基 板1とほぼ同一寸法のスタンパ、5はマスクパターン、 6は薄膜パターンである。

【0021】そして、薄膜2としては、導体の場合は、 例えば、アルミニューム(A1)やクローム(Cr)、 半導体の場合は、例えば、多結晶シリコン(p-Si) や非晶質シリコン(A1-Si)、絶縁体の場合は、例 えば、二酸化シリコン(SiO2)や窒化シリコン(S i3N4)等が用いられ、薄膜2は従来周知の真空蒸着や スパッタリングあるいはCVD等の手段により基板1上 に形成される。また、スタンパ4は、下部にマスクパタ ーン5と同一構成の凹凸を持った版面が形成されてい る。

【0022】本実施例の製造方法は、以下に述べるよう な順序工程によって実施される。

【0023】始めに、図の(a)に示すように、基板1 上に前述の周知の手段により導体または半導体あるいは 絶縁体の薄膜2を形成し、こうして形成した薄膜2上に 液体状の有機樹脂を均一に塗布して有機樹脂層3を形成 する。次いで、この有機樹脂層3上にスタンパ4を位置 させ、基板1とスタンパ4との位置合わせを行ない、位 置合わせが完了すると、スタンパ4を基板1側に移動さ せ、スタンパ4により未硬化の有機樹脂層3に均一に加 圧押し付け(型押し)を行なう。この加圧押し付けによ り、有機樹脂層3は、スタンパ4の凸部で分離され、基 板1とスタンパ4の凹部との間に形成される空隙内だけ に閉じ込められる。この場合、基板1とスタンパ4の凸 部が密着する領域に有機樹脂が残存することはない。な 一の長さを有する円筒状スタンパを用い、前記基板上に 30 お、スタンパ4は、有機樹脂に対して剥離性が高く、さ らに適当な強度を有する材質で構成される。また、ここ に用いられる液体状の有機樹脂は、その溶媒を加熱等の 方法で蒸発させることにより硬化し、硬化後は耐溶剤性 が高いものである。さらに、有機樹脂を塗布した後、適 当に温度を制御するとともに、時間を調整して有機樹脂 層3の粘度を調節し、最適な粘度になったときにスタン パ4で型押しを行なうことが望ましい。

【0024】次に、図の(b)に示すように、スタンパ 4を基板1から離間させると、基板1上の所定の位置 薄膜パターン製造の際のスループットの向上が可能にな 40 に、所定の寸法形状に成型された有機樹脂部分が残存す る。この有機樹脂部分が残存した基板1を、例えば、加 熱装置に供給して前記有機樹脂部分を加熱硬化させ、さ らに、前記硬化温度を維持したまま一定時間加熱して前 記有機樹脂部分と薄膜2との密着性を上げ、薄膜2上に エッチング用の保護マスクとなるマスクパターン5を形 成させる。

> 【0025】次いで、図の(c)に示すように、保護マ スクとなるマスクパターン5を用いて薄膜2のエッチン グを行ない、マスクパターン5でマスクされている部分 50 以外の薄膜を除去する。なお、このエッチングには、加

工精度、薄膜2の材質等により、ウエットエッチングま たはドライエッチングのどちらかが選択使用される。続 いて、図の(d)に示すように、硬化した有機樹脂部 分、即ち、マスクパターン5を剥離用の溶剤またはプラ ズマアッシャ等により除去し、基板1上に薄膜パターン 6を形成させるものである。

【0026】この場合、本実施例において、スタンパ4 を、例えば、ポリカーボネート、ポリメチルメタアクリ レート、ガラス等の光透過性を有する材質で形成すれ ば、スタンパ4を通して基板1を見ることができるの 10 光層8により感光されないために未感光部3bとなる。 で、基板1とスタンパ4との位置合わせが容易になる。

【0027】さらに、本実施例において、前記光透過性 を有するスタンパ4を用いるとともに、有機樹脂として 光硬化性を有するものを用い、基板1上に形成された有 機樹脂層3に前記スタンパ4で加圧押し付けを行なって 所望の寸法形状の有機樹脂部分を成型し、その後、未硬 化の有機樹脂部分に前記光透過性を有するスタンパ4を 通して適当な光を照射し、硬化させるようにしてもよ い。この手段によれば、高精度の寸法形状の保護用のマ スク(マスクパターン5)が得られる。

【0028】本実施例によれば、大面積の基板1を用い たときでも、スタンパ4により一度に基板1全面の有機 樹脂層3を任意の形状に成型してマスクパターン5を形 成することができるため、高いスループットで薄膜パタ ーン6を形成することができる。

【0029】次に、図2の(a)乃至(d)は、本発明 に係る薄膜パターン製造方法の第2の実施例を示す構成 図である。

【0030】図2において、3aは感光部、3bは未感 光部、7は光透過性を有する材質で構成したスタンパ、 8は遮光部であり、その他、第1の実施例と同じ構成要 素には同じ符号を付けている。

【0031】そして、スタンパ7には、前記スタンパ4 と同様に、下部にマスクパターン5と同一構成の凹凸を 持った版面が形成され、その凸部には遮光部8が形成さ れている。

【0032】本実施例の製造方法は、以下に述べるよう な順序工程によって実施される。

【0033】始めに、図の(a)に示すように、基板1 上に導体または半導体あるいは絶縁体の薄膜2を形成 40 し、こうして形成した薄膜2上に液体状の感光性(光硬 化性) 有機樹脂を均一に塗布して有機樹脂層3を形成す る。次いで、この有機樹脂層3上にスタンパ7を位置さ せ、基板1とスタンパ7との位置合わせを行ない、位置 合わせが完了すると、スタンパ7を基板1側に移動さ せ、スタンパ7により未硬化の有機樹脂層3を均一に加 圧押し付けを行なう。この加圧押し付けにより、スタン パ4の凸部に対応した部分の有機樹脂は押し出されてな くなり、全て凹部に対応した部分に集まるようになる が、実際にはスタンパ4の加圧押し付けが不十分であっ 50 寸法形状の保護用のマスク(マスクパターン)5を形成

たりして、有機樹脂層3はスタンパ4の凸部に対応した 部分がかなり薄くなり、凹部に対応した部分が厚くなる ように構成される。

【0034】次に、図の(b)に示すように、光透過性 のスタンパ7を通して有機樹脂層3の上に紫外線(U V) を照射する。この紫外線(UV)の照射により、光 透過性スタンパイの凹部内に閉じ込められた感光性有機 樹脂は感光されて感光部3aとなり、一方、スタンパ7 の凸部に対応した部分に残っている感光性有機樹脂は遮

【0035】次いで、図の(c)に示すように、光透過 性のスタンパ7を基板1から離間させると、基板1上の 所定の位置に感光部3aと未感光部3bとが形成され る。このとき、感光性有機樹脂を現像液で現像処理を行 なうと、感光部3aと未感光部3bとの間では現像液に 対する溶解度が異なるために、未感光部3bは溶解除去 され、図の(d)に示すように、基板1上には感光部3 aだけからなる保護用のマスク(マスクパターン)5が 形成される。その後は、第1の実施例の図1の(d)に おいて行なったような工程を経ることにより、基板1上 に薄膜パターンが形成される。

【0036】本実施例によれば、第1の実施例と同様の 効果が得られるとともに、スタンパ7の加圧押し付けが 不十分であっても、高精度で薄膜パターンを形成するこ とができるという効果がある。

【0037】また、図3は、本発明に係る薄膜パターン 製造方法の第3の実施例を示す構成図である。

【0038】図3において、9は円筒状スタンパであ り、その他、第1及び第2の実施例と同じ構成要素には 同じ符号を付けている。 30

【0039】そして、円筒状スタンパ9は基板1の有効 領域の幅とほぼ同じ長さの円筒で構成され、その表面に はマスクパターン5と同一構成の凹凸を持った版面が形 成されている。また、この円筒状スタンパ9は基板1上 を滑ることなく転がるように配置されている。

【0040】本実施例の製造方法は、以下に述べるよう な順序工程によって実施される。

【0041】図3に示すように、基板1上に導体または 半導体あるいは絶縁体の薄膜2を形成し、こうして形成 した薄膜2上に液体状の有機樹脂を均一に塗布して有機 樹脂層3を形成する。次いで、この有機樹脂層3上に円 筒状スタンパ9を位置させ、基板1とスタンパ9との位 置合わせを行ない、位置合わせが完了すると、スタンパ 9を基板1側に移動させ、スタンパ9により未硬化の有 機樹脂層3に加圧押し付けを行なう。続いて、円筒状ス タンパ9を矢印方向に回転させ、基板1上を滑ることな く転がすようにすれば、円筒状スタンパ9の凸部に対応 した部分の有機樹脂は排除され、凹部に対応した部分の 有機樹脂だけが残るので、基板1上の所定位置に任意の

することができる。そして、その後は、前述の実施例と 同様に、エッチング処理及び保護用のマスク(マスクパ ターン) 5の除去処理を行なう工程を経ることにより、 基板1上の薄膜2のパターニングを行なうことができ

【0042】本実施例によれば、円筒状スタンパ6の転 がる回数を増加させることにより、円筒状スタンパ6の 版面の凹凸パターンに対応した有機樹脂の成型体を、基 板1上に任意の寸法形状で連続して形成することができ る。このため、本実施例は、例えば、TFT液晶パネル 10 のように、基板 1 全面を同一パターンに形成するような 場合に用いると有効なものである。

【0043】なお、本実施例においては、円筒状スタン パ9を基板1上を転がすようにしているが、円筒状スタ ンパ9を固定位置で回転させるとともに、基板1を前記 回転速度に同期させて移動させるようにしても同様の機 能が達成される。

【0044】本実施例によれば、大面積の基板1上に同 一の寸法形状を有する薄膜パターンを連続的に形成でき るという効果がある。

【0045】次に、図4は、本発明に係る薄膜パターン 製造方法の第4の実施例を示す構成図である。

【0046】図4において、10は有機樹脂供給装置、 11は加熱装置、12は回転ローラであり、その他、前 述の各実施例と同じ構成要素には同じ符号を付けてい る。

【0047】本実施例においても、円筒状スタンパ9は 基板1の有効領域の幅とほぼ同じ長さの円筒で構成さ れ、その表面にはマスクパターン5と同一構成の凹凸を 持った版面が形成されている。また、円筒状スタンパ9 と回転ローラ12とは同期して精度良く回転し、円筒状 スタンパ9の回転速度と基板1の移動速度が同期するよ うに構成されている。有機樹脂供給装置10は円筒状ス タンパ9の上流側において基板1上に有機樹脂を供給 し、加熱装置11は円筒状スタンパ9の下流側に配置さ れている。

【0048】本実施例の製造方法は、以下に述べるよう な順序工程によって実施される。

【0049】図4に示すように、基板1上に導体または した基板1を回転ローラ12上に載置して矢印方向に移 動させるとともに、円筒状スタンパ9を回転させる。こ のとき、有機樹脂供給装置10により基板1と円筒状ス タンパ9との間に必要量の有機樹脂を供給すると、基板 1上に供給された有機樹脂は、基板1とともに搬送さ れ、円筒状スタンパ9の円周上の版面の凹凸部による加 圧押し付けが行なわれる。この際に、円筒状スタンパ9 の凸部に対応した部分の有機樹脂は排除され、凹部に対 応した部分の有機樹脂だけが残るので、基板1上の所定

10 いで、基板1上の有機樹脂部分を加熱装置11に加えて

硬化させれば、その出力側に第1の実施例の図1の (b) に示すような保護用のマスク (マスクパターン) 5を得ることができる。この後は、前述の各実施例と同 様に、エッチング処理及び保護用のマスク(マスクパタ ーン) 5の除去処理を行なう工程を経ることにより、基 板1上に薄膜2のパターニングを行なうことができる。

【0050】本実施例によれば、第3の実施例と同様 に、基板1上に有機樹脂部分を連続して成型することに よってマスクパターン5を得るようにしているので、大 面積の基板1に形成された薄膜のパターニングを高いス ループットで、しかも高精度に行なうことができる。

【0051】また、図5は、本発明に係る薄膜パターン 製造方法の第5の実施例を示す構成図である。

【0052】図5において、13は有機樹脂供給装置、 14はワイピングローラであり、その他、前述の各実施 例と同じ構成要素には同じ符号を付けている。

【0053】本実施例においても、円筒状スタンパ9は 基板1の有効領域の幅とほぼ同じ長さの円筒で構成さ 20 れ、その表面にはマスクパターン5と同一構成の凹凸を 持った版面が形成されている。また、円筒状スタンパ9 は同一位置で回転を行ない、その回転速度と基板1の移 動速度が同期するように構成され、有機樹脂供給装置1 3は円筒状スタンパ9の上側において円筒状スタンパ9 に有機樹脂を供給する。さらに、ワイピングローラ14 は、円筒状スタンパ9とほぼ同じ長さの円筒で構成さ れ、円筒状スタンパ9との接触面においてその円周の移 動方向と逆になるように回転し、円筒状スタンパ9の表 面の余分な有機樹脂を掻き取っている。

【0054】本実施例の製造方法は、以下に述べるよう な順序工程によって実施される。

【0055】図5に示すように、基板1上に導体または 半導体あるいは絶縁体の薄膜2を形成し、薄膜2を形成 した基板1を矢印方向に移動させるとともに、円筒状ス タンパ9を回転させる。このとき、有機樹脂供給装置1 3から円筒状スタンパ9の上側部に有機樹脂を供給し て、円筒状スタンパ9の表面に有機樹脂を付着させた 後、ワイピングローラ14において余分な有機樹脂を掻 き取り、円筒状スタンパ9の凹部のみに有機樹脂を詰め 半導体あるいは絶縁体の薄膜2を形成し、薄膜2を形成 40 込むようにしている。次いで、円筒状スタンパ9が回転 し、有機樹脂が詰め込まれた面がこの円筒状スタンパ9 と同期して移動する基板1と接触すると、円筒状スタン パ9の凹部に詰め込まれている有機樹脂が基板1上の所 定位置に転写され、円筒状スタンパ9の凹凸のパターン に対応した有機樹脂部分が基板 1 上に形成される。続い て、基板1上に形成された有機樹脂部分を適当な方法に より硬化させれば、第1の実施例の図1の(b)に示す ような保護用のマスク(マスクパターン)5を得ること ができる。この後は、前述の各実施例と同様に、エッチ 位置に任意の寸法形状の有機樹脂部分が形成される。次 50 ング処理及び保護用のマスク(マスクパターン)5の除

去処理を行なう工程を経ることにより、基板1上に薄膜 2のパターニングを行なうことができる。

【0056】本実施例によれば、第3乃至第4の実施例 と同様に、エッチング時の保護マスクを高精度で連続的 に形成することができ、大面積の基板1に形成された薄 膜のパターニングを高いスループットで、しかも高精度 に行なうことができる。

### [0057]

【発明の効果】請求項1乃至4記載の発明によれば、ス タンパにより直接有機樹脂層の成型を行なっているの 10 施例を示す構成図である。 で、従来のこの種の手段で必要であった現像工程が不要 になり、薄膜パターン製造の際のスループットの向上が 可能になる。また、一度に基板全面に有機樹脂層からな るマスクパターンが成型できるため、大面積の基板のと きでもマスクパターンのつなぎ合わせが不要となり、基 板全面に高い寸法精度で薄膜パターンが製造できるとい う効果がある。

【0058】また、請求項5乃至8記載の発明によれ ば、前の発明と同様に、スタンパにより直接有機樹脂層 の成型を行なっているので、従来のこの種の手段で必要 20 5 マスクパターン であった従来の現像工程が不要になり、薄膜パターン製 造の際のスループットの向上が可能になる。また、一つ の工程により基板全面に有機樹脂層からなるマスクパタ ーンが成型できるため、大面積の基板のときでもマスク パターンのつなぎ合わせが不要となり、基板全面に高い 寸法精度で薄膜パターンが製造できるという効果があ る。

【図面の簡単な説明】

[閏1]

【図1】本発明に係る薄膜パターン製造方法の第1の実 施例を示す構成図である。

12

【図2】本発明に係る薄膜パターン製造方法の第2の実 施例を示す構成図である。

【図3】本発明に係る薄膜パターン製造方法の第3の実 施例を示す構成図である。

【図4】本発明に係る薄膜パターン製造方法の第4の実 施例を示す構成図である。

【図5】木発明に係る薄膜パターン製造方法の第5の実

【図6】従来の薄膜パターン製造方法の一例を示す構成 図である。

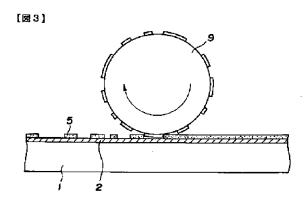
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 薄膜
- 3 有機樹脂層
- 3 a 感光部
- 3 b 未感光部
- 4、7 スタンパ
- - 6 薄膜パターン
  - 8 遮光層
  - 9 円筒状スタンパ
  - 10、13 樹脂供給装置
  - 11 加熱装置
  - 12 回転ローラ
  - 14 ワイピングローラ

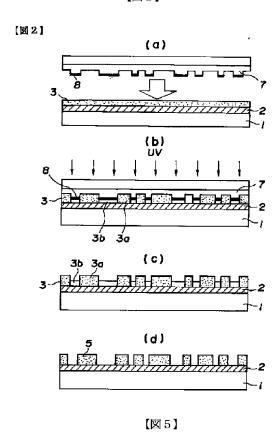
【図1】

(d) ·

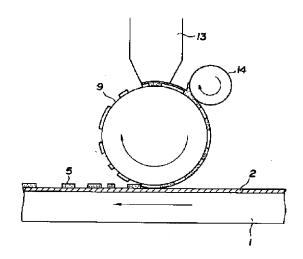
【図3】



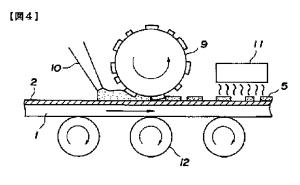
【図2】



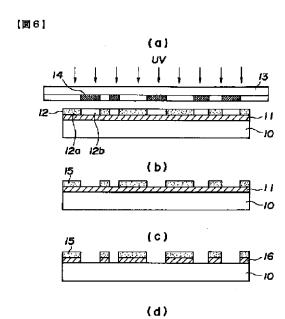
[图5]



【図4】



【図6】



フロントページの続き

 (51) Int. Cl.5
 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所

// H 0 5 K 3/06 E 6921-4E